タングステン単結晶標的を用いた陽電子生成実験

古川 和朗^{1,A)}、穴見 昌三^{A)}、梅森 健成^{C)}、榎本 收志^{A)}、大越 隆夫^{A)}、大沢 哲^{A)}、
小川 雄二郎^{A)}、奥野 英城^{A)}、柿原 和久^{A)}、笹原 和俊^{B)}、紙谷 琢哉^{A)}、諏訪田 剛^{A)}、
浜津 良輔^{B)}、藤田 貴弘^{C)}、吉田 勝英^{C)}、V. Ababiy^{D)}、A. P. Potylitsyn^{D)}、I. E. Vnukov^{D)}
^{A)}高エネルギー加速器研究機構 (KEK)、〒 305-0801 茨城県つくば市大穂 1 - 1

B) 東京都立大学、〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1

^{C)}広島大学、〒739-8526 広島県東広島市鏡山 2 - 313

^{D)} Tomsk Polytechnic University, P.O.Box 25 Lenin Ave. Tomsk, 604050, Russian Federation

概要

次世代の高エネルギー電子陽電子衝突型加速器においては、発熱などの問題を克服しながら、収率の高い 陽電子生成部を設計することが大きな課題のひとつとなっている。単結晶標的を用いて陽電子を生成すると、 発生するチャネリング放射光とコヒーレント制動放射 によって陽電子生成効率が増大することが期待され、この振る舞いを定量的に把握することが求められてきた。 今回 KEK の電子線形加速器において 8 GeV 電子を厚 さ 2.2mm と 9mm のタングステン結晶標的に照射して 得られる陽電子生成の測定を行なった。得られた実験 データを利用して今後シミュレーションコードの精度を 向上させることができれば、高効率の新しい陽電子源の 設計が可能になると期待される。

1. はじめに

電子・陽電子衝突型加速器においては、衝突する粒子 の質と量が実験効率を決めることになるが、そのうち、 特に陽電子発生源の性能が効率を左右する大きな要因 になる。

例えば、KEK の電子・陽電子線形加速器においては、 要求される陽電子を発生させるために、パルスあたり 10 nC という大電流で 3.7 GeV という高いエネルギーの 一次電子を安定に生成し、それを重金属の標的に照射し て、発生する陽電子を捕獲利用している^[1]。

このうち、大出力電子銃に引き続く集群装置におい ては、周波数の異なるサブハーモニック・バンチャを安 定に動作させる必要がある。集群装置でも高い加速電界 が必要になるが、陽電子発生装置においても、位相空間 に大きく広がって発生する陽電子を捕獲するために、高 い収束磁場と大きな加速電界が必要となる。そのような 部分では、放電による加速管の損傷が大きな問題となっ

¹E-mail: kazuro.furukawa@kek.jp

ている^[2]。

このような困難を克服して、安定な陽電子が生成で きるように、さまざまな Feedback Loop や監視装置を 稼働させている^[3]。また、今後複数バンチによる陽電 子の倍増も、ウェイク場の問題を解決しながら、実現す べく試験している^[4, 5]。

しかし、次世代のリニア・コライダでは、さらにバン チ数を増やして、百バンチ程度の一次電子を標的に導 くことが検討されており、その場合は標的の発熱が大き な課題となっている。この課題が解決されないならば、 標的を融体にするなどの対策も考えなくてはならない かもしれない。

このような状況を打開するために、他の陽電子生成 の過程によって陽電子の収量を向上させる方法も検討 されている。その中で、Chehab らによって提案された 単結晶標的を用いる方法^[6]は新しい方法として期待さ れている。国内においても、陽電子収率の増大の確認を して、将来の利用方法を検討するための実験が始まった ^[7]。

2. 単結晶を用いた陽電子の発生

従来の多結晶または非晶質を用いた陽電子発生に比 ベ、単結晶を用いた場合には、一次電子が結晶軸に沿っ て入射した場合に、チャネリング放射光やコヒーレント 制動輻射により低エネルギー(< 20MeV)光子数が増 大し、その結果、生成陽電子数が増大する。この効果を 利用するためには、結晶軸を一次電子の入射方向に合わ せるためのゴニオメータが必要となるが、他に特殊な装 置が必要ないので、既存の加速器を利用した実験が考え やすい。

KEK の電子線形加速器においては、まず、既存の陽 電子発生装置の標的の直前に放射長の 0.5 倍 (1.7mm)の タングステン単結晶をおいて陽電子収量の増大を確認



図 1: 実験に使われた標的、分析電磁石、測定器、等の配置

した^[8]。

これらの実験やシミュレーションによると、陽電子収 率の増大は残念ながらそれほど大きくないことがわかっ てきているが、同じ量の陽電子を得るのに必要な標的の 厚さを薄くすることができるので、発熱量を抑えること が可能であると思われるため、特にリニアコライダには 有望である。

そこで、結晶標的を用いた陽電子発生装置を、目的や 条件に応じて設計できるように、精度の高いシミュレー ションコードを開発することが計画されている。その中 では、陽電子の発生効率だけでなく、発生した陽電子の 捕獲効率も合わせて計算できることが重要になる。現 在のところ、電磁シャワーのシミュレーションコードの 素過程にチャネリング放射光やコヒーレント制動輻射 の効果を追加して、さらに標的後の電磁場の中の陽電 子の飛跡追跡を行なうことが考えられている。しかし、 そのコードの有効性を確認するためには、陽電子発生に ついて、一次電子エネルギーや角度依存性、そして陽電 子のエネルギー分布などの実験情報が必要となる。

この実験情報を収集するために、条件を変えた2回の実験を行ない、解析を進めている^[9, 10]。

3. 実験方法

KEK の電子線形加速器はパルス運転を行なうので、 陽電子を計数する実験は適さない。そこで、1パルス内 で多量に発生する陽電子をまとめて観測することにし た。測定器の測定可能範囲を正しく把握していれば、精 度を容易に高めることが可能となる。

実験は加速器の終端近く(第3スイッチヤード)の エネルギー分析ラインで行なわれた。8 GeV に分析さ れたビームを、標的に収束させるために四重極磁石が使 われ、また、ビーム診断用に蛍光板ビーム形状モニタと 壁電流モニタが用いられた。

調整された一次電子は、結晶軸を合わせるためにゴ ニオメータに取りつけられたタングステン単結晶標的 に導かれ、陽電子を発生させる。陽電子は鉛コリメータ を通って、小型 60 度分析電磁石と 3 つの鉛コリメータ とでエネルギー分析された後、ルーサイト・チェレンコ フ検出器、さらに鉛ガラス検出器に到達する(図 1)。 空気による散乱吸収に影響されずに、低エネルギーの陽 電子を測定するため、測定器自体を含めて、標的直後か らの経路には真空箱を設けた。また、一次電子を起源と するバックグラウンドを避けるため十分な鉛シールドを 積んだ。

ゴニオメータは4軸の自由度を持ち、陽電子の収量 の変化を見て、ビーム方向と結晶軸を合わせることがで きる。また、測定器から得られる信号は、入射した陽電 子の数に比例するよう、注意深く光電子増倍管の高電圧 が調整された。測定器の信号は、標的直前の一次電子の 電荷量を表す壁電流モニタの信号とともに、電荷感応型 ADC で数値に変換され Linux 計算機で収集された。

標的としては、2.2 mm と 9 mm の単結晶と、較正の ためにいくつかの厚さの多結晶タングステンを用いて 情報を比較した。実験中は、信号の線形性やノイズなど に十分注意が払われ、情報の信頼性が失われないよう配 慮した。

4. 実験結果

実験の結果、陽電子収量の角度依存性、標的厚さ依存 性、陽電子エネルギー依存性、等の情報を得ることがで きた。収量の絶対値については、現在のところ推定が困 難であるが、相対値についてはほぼ誤差の小さい情報 が得られたと考えているが、さらにモンテカルロシミュ レーションとの比較を含めて解析検討を進めている。

図2は2.2 mmと9 mmの厚さの単結晶標的につい て、20 MeV/cの陽電子収量に対する、結晶の (111) 面 に垂直な軸と入射一次電子との角度の依存性を表して いる。軸の周りではチャネリング放射光やコヒーレント 制動輻射によって陽電子の収量が増えている。現在のと ころ、ピークの幅が2.2 mm について9 mrad (FWHM)、 9 mm について39 mrad (FWHM)と、チャネリング放射 光から予想される幅 (< 1mrad) に比べ大きいことから 主にコヒーレント制動輻射の効果が大きいものと考え ている。

ピークのすそでは、単結晶の効果はほとんどなく多 結晶と同じ陽電子量が得られていると考えられるので、



図 2: 2.2 mm(上) と 9 mm の標的についての陽電子収量の 角度依存性

ピークの陽電子量と比較することによって、増倍率は 2.2 mm の標的について 5.1 ± 0.1 倍、9 mm について 1.7 ± 0.1 倍、という値が得られた。

図3は単結晶と多結晶標的についての20 MeV/cの陽 電子収量の標的厚さ依存性を表している。まだ情報が少



図 3: 単結晶と多結晶の標的についての陽電子量の厚さ依存性

いが、多結晶標的で最も陽電子収量が多くなる 14 mm の厚さのものに比べ、9 mm の厚さの単結晶標的は劣っ ていない。つまり、同じ量の陽電子を得るために、単結 晶であれば、薄い標的を用いることができることを示し ている。このことは標的での発熱が少く、また発生分布 が前方に片寄るので陽電子の質(エミッタンス)が少し 良くなることが期待される。

5. まとめ

今回の実験で、単結晶を用いた場合の陽電子の収量 について、入射角度、陽電子エネルギー、標的厚さなど の知見が得られ、さらにシミュレーションと比較しなが ら解析を進めている。これまでのところ、実験結果は、 将来の電子陽電子衝突実験で単結晶標的を用いた陽電 子生成が有用となる可能性のある情報を示しており、今 後、さらに詳しい実験を行ないたいと考えている。

また、可能であれば入射電子エネルギー依存性など の実験も行ない、それらを参考にして、単結晶から生成 される陽電子のシミュレーションコードを作成し、実験 情報を再現できるかどうか試験して、さらには、リニア コライダ等の陽電子生成装置を設計できるコードに発 展させることを期待したい。

参考文献

- A. Enomoto, "Upgrade to the 8-GeV Electron Linac for KEKB", Proc. LINAC'96, Geneva, Switzerland, 1996, p.633.
- [2] K. Furukawa et al., "Towards Reliable Acceleration of High-Energy and High-Intensity Electron Beams", Proc. LINAC2000, Monterey, U.S.A., 2000, p.630.
- [3] K. Furukawa et al., "Beam Switching and Beam Feedback Systems at Kekb Linac", Proc. LINAC2000, Monterey, U.S.A., 2000, p.633.
- [4] Y. Ogawa *et al.*, "KEKB ライナックにおける陽電子倍増 のための大強度2バンチ加速", these proceedings.
- [5] K. Furukawa *et al.*, "KEKB 入射器の 2 バンチ加速に向 けた BPM 読み出しとビームフィードバック", these proceedings.
- [6] R. Chehab et al., Orsay Report LAL-RT 89-01, 1989.
- [7] K. Yoshida *et al.*, "Positron Production in Tungsten Crystal by 1.2 GeV Channeling Electron", Phys. Rev. Lett. 80, 1998, p.1440.
- [8] M. Inoue *et al.*, "Experiment of Positron Generation using a Crystal Target at the KEK Electron/Positron Linac", Nucl. Instr. and Meth. B **173**, 2001, p.104.
- [9] T. Suwada et al., "Positron-Production Experiment by 8-GeV Channeling Electrons in Crystal Tungsten at the KEKB Injector Linac", Proc. HEACC2001, Tsukuba, 2001.
- [10] K. Sasahara *et al.*, "Positron Production from a Tungsten Single Crystal at the KEK 8-GeV Electron Linac", Proc. 21st ICFA Beam Dynamics Workshop, Stony Brook, 2001.